(54) PRODUCTION OF FERRITE RAW MATERIAL

(11) 2-212319 (A)

(43) 23.8.1990 (19) JP

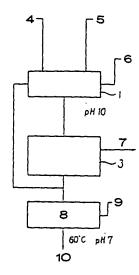
(21) Appl. No. 64-31508 (22) 10.2.1989

(71) NEC CORP (72) SHUNICHI EMA(2)

(51) Int. Cls. C01G49/00

PURPOSE: To highly concentrate the solution of ferrite raw material in the production process thereof where iron (II)-contg. waste water is neutralized with an alkali agent to produce hydroxide, which is concentrated to produce the source material of ferrite, by adding a specific amt. of iron (III) in the neutralization process.

CONSTITUTION: Calcium hydroxide is added to the iron (II)-contg. waste water in a neutralization tank 1 to produce a precipitate slurry contg. iron (II) hydroxide, which is separated from the liquid in a separatory thickener 3. The obtd. iron (II) hydroxide is used as the source or a part of the source material of ferrite. In this process, a portion of the iron (II) hydroxide obtained in the thickener 3 and iron (III) is added to the neutralization tank 1 in a manner that the amt. of iron (III) in the tank 1 is less than twice by weight as that of iron (II). Thereby, the solution can be concentrated to high concentration, so that the capacity of the reaction tank to produce ferrite can be reduced, which saves not only the area for installation but energies required for mixing, heating, etc.



4: waste water, 5: iron (III) solution, 6: calcium hydroxide, 7: separated liquid, 8: reaction tank to produce ferrite, 9: iron (III) solution, 10: ferrite

(54) PRODUCTION OF IRON NITRIDE HAVING HIGH MAGNETISM

(11) 2-212320 (A)

(43) 23.8.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-32793 (22) 14.2.1989

(71) MITSUBISHI STEEL MFG CO LTD(2) (72) KIMIYUKI JINNO(2)

(51) Int. Cl⁵. C01G49/00,C23C14/48,H01F41/14

PURPOSE: To produce $Fe_{15}N_2$ as pure as possible by a rather feasible method by injecting ions into an iron thin film on a nonmagnetic substrate with using different kinds of N ions for several times.

CONSTITUTION: In a single crystal iron thin film formed on a nonmagnetic substrate, e.g. MgO single crystal substrate, by epitaxial growth, nitrogen ions (N^+) and successively nitrogen ions (N_2^+) are injected. In one embodiment of this process, the N^+ ions are injected so that the nitrogen ion concentration is maximum at the depth of 3/4 thickness of the iron thin film from its surface. Then the successive ion injection of N_2^+ ions is performed in a manner that the total concentration of nitrogen ions from the first injection of N^+ ions above described to the second and successive injections of N_2^+ ions has a distribution of trapezoid shape versus the thickness direction of the film. Thereby, $Fe_{16}N_2$ and precursors of $Fe_{16}N_2$ are produced as the main phase in the iron thin film.

(54) REFORMED MAGNETIC OXIDE POWDER

(11) 2-212321 (A)

(43) 23.8.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-32311 (22) 10.2.1989

(71) MITSUBISHI PETROCHEM CO LTD (72) YOSHIAKI SAWADA(2)

(51) Int. Cl⁵. C01G49/02

PURPOSE: To improve the wear resistance, sliding properties and electrical conductivity of the reformed magnetic oxide powder by coating the surface of

the magnetic oxide with graphite.

CONSTITUTION: The reformed magnetic oxide powder is the magnetic oxide powder having the surface coated with graphite. As the magnetic oxide powder, $\gamma \text{Fe}_2 \text{O}_3$, Oo-formed $\gamma \text{Fe}_2 \text{O}_3$, etc., obtd. by a normal acicular geothite method are used and transition metals such as Fe, Co and Ni or their alloys are used; the grain size is suitably regulated to $\leq 1\mu$. The formation of the coating of graphite can be executed by the method of bringing the surface of the oxide powder into contact with hydrocarbon or water gas and decomposing it. At this time, for $>600^{\circ}\text{C}$ reaction temp., besides the reaction of forming graphite. sintering occurs between the oxides to tend to deteriorate the magnetic properties, so that it is not preferable.

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-212320

⑤Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 每公開 平成2年(1990)8月23日

C 01 G 49/00 C 23 C 14/48 H 01 F 41/14 Z 8618-4G 8520-4K

7354-5E

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

◎発明の名称

高い磁性を有する窒化鉄の製造方法

頭 平1-32793 20特

頭 平1(1989)2月14日 22出

⑫発 明 者 野 公 ñ 東京都江東区東雲1-9-31 三菱製鋼株式会社技術開発

センター内

個発 明 圌 本 者

祥

新潟県長岡市大島本町2-8-20

@発 明 者 中 島 健 介

健 介 新潟県見附市上新田町466-8

会出 顋 人 三菱製鋼株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番2号 新潟県長岡市大島本町2丁目8番地20

の出 顋 人 圌 本 祥 中

新潟県見附市上新田町466番8

弁理士 小松 秀岳 四代 理 人

島

外2名

明細書

1. 発明の名称

创出

顧 人

髙い磁性を有する窒化鉄の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1)非磁性の基板上に形成されている鉄薄膜に、

窒素イオン (N·)を注入し、最いて堅素イ オン(N2*)を注入し、所定の組成の窒化 鉄とすることを特徴とする高い単性を有する 窒化鉄の製造方法。

- (2) 非磁性基板が酸化マグネシウムの単結晶で あり、その上に形成されている鉄薄膜が、エ ピタキシャル成長させた鉄単結品であること を特徴とする上記請求項(1)記載の高い磁性 を有する窒化鉄の製造方法。
- (3) 窒素イオン (N*) のイオン注入工程にお いて、鉄薄膜の厚さ方向で表面から 3/4の深 さに窒素イオン濃度が極大になるように注入 し、次の窒素イオン (N2 *) の注入は、上 記室業イオン(N⁴)の注入による窒素イオ ン歳度と、2回目以降の窒素イオン(N2*)

の注入による窒素イオン遺皮との和が鉄薄膜 中で台形分布(第1図参照)となるように注 入することを特徴とする上記請求項(1) また は(2) 記載の高い磁性を有する窒素鉄の製造 方法。

- (4) 窒素イオン (N*およびN2*) の注入の 結果、鉄薄膜中の生成物が、Fes N 2 およ びFesNz形成前段階組成物が主相となる ようにすることを特徴とする上記請求項(1) ないし(3)の何れかに記載の高い磁性を有す る窒化鉄の製造方法。
- (5) 上記請求項(3) に記載の製造方法で製造し た窒化鉄薄膜を、無処理することによって飽 和磁化の値を増大させることを特徴とする高 い磁性を有する窒化鉄の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、高磁性、特に、高い飽和磁化の値 を有する窒化鉄の製造方法に係る。

【従来の技術】

そこで高橋は充分に消かに保ったベルヂャー内に99.999%のN2ガスを 2×10⁻³ ~ 7×10⁻³ Torr満たし、鉄を蒸発させて a ² - F e s N 2 の形成を試みた。この試みでも蒸着後に得られたものは、 a F e (b.c.c.) + a ² F e s N 2 (b.c.t.) の二相共存であった。

その後多くの研究者が反応性スパッタ法、イ オンブレーティング法、粉末法、ブラズマ法等 を用いて、FesNzの形成を試みてきたか、 純粋な形で抽出するに至っていない。

[発明が解決しようとする課題]

本免明は、比較的実施し易い方法によって、できるだけ純粋なFesNzを製造しようとするものである。

[翠斑を解決するための手段]

すなわち、本発明の構成は、下記のとおりの 高い磁性を有する窒化鉄の製造方法である。

- (1) 非磁性の基板上に形成されている鉄薄膜に、 窒素イオン (N*) を注入し、続いて窒素イ オン (N2*) を注入し、所定の組成の窒化 鉄とする、高い磁性を有する窒化鉄の製造方 法。
- (2) 非磁性基板が酸化マグネシウムの単結晶であり、その上に形成されている鉄薄膜が、エ

ビタキシャル成長させた鉄単結品である、上記(1) 項記載の高い磁性を有する窒化鉄の製造方法。

(3) 窒素イオン (N・) のイオン注入工程において、鉄薄膜の厚さ方向で装面から 3/4の深さに窒素イオン濃度が極大になるように注入

- (4) 窒素イオン(N・およびN 2・)の注入の 結果、鉄薄膜中の生成物が、FenN 2 およ びFenN 2 形成前及組成物が主相となるよ うにする上記(1) 項ないし(3) 項の何れかに 記載の高い磁性を有する窒化鉄の製造方法。
- (5) 上記(3) 項に記載の製造方法で製造した室 化鉄薄膜を、熱処理することによって飽和磁

化の値を増大させる高い磁性を有する窒化鉄 の製造方法。

近年のイオン注入法は高級皮に注入でき、添 加深さを高制度に制御でき、しかも室温で熱溶 解皮以上に高級皮注入ができる特徴をもってい る。

しかし単に登業イオンを規定量鉄薄膜中に注入しても、注入された登業イオンは薄膜中でガウス分布をとって存在するために、目的とするFesN2は、それを形成するに通した登業イオン濃度をもつ限定された領域にしか存在しなくなり、実用材料としては好ましくない。

このような火点を克服するために、本発明では注入空索イオンの種類、加速電圧、注入量を変えて複数回注入する事により、第1図に示すように、甚板(サブストレート)上の鉄薄膜の厚さ方向に窒素減度の一定の領域を出現させることに特徴がある。

第 1 図において曲線 1はイオン注入装置の放 電部でイオン化された窒素イオンは、次々と加 速音で連続加速され、所定の加速電圧に加圧される。続いてマスアナライザー部に達した窒素イオンは、独界速度を変化させることによりN・とN2・に分離することができる。 先ず最初にN・を世界により90°に曲げ、次のQP(クオドロ・ポール)部へ送り込まれ、更にディフレクター部で中性粒子を除去するため道流 花匠をかけ 7°曲げて、鉄搏膜面へ達する。

る点に特徴があり、鉄薄膜の底部に注入するには空素イオン(N・)を選ぶ。この場合窒素は 炭素と殆ど似た質量を有するため、炭素の分離 を光分に行なわねばならない。

[実施例]

次に本発明の詳細を実施例で説明するか、 れに限定されるものではない。

灾施例1

20 mm× 20 mmの M g O 単結晶 基 板 上 に 、 A r 圧 0.3 P a 、 高 周 波 電 力 400 W で 鉄 の 単 結晶 膜 を 形 成 し た 。 膜 面 の X 線 回 折 か ら (100) 方 位 に 配 向 さ れ て い る 事 を 確 認 し た 。 次 に 表 1 で 示 す 条 件 で イ オ ン 注 入 を 行 な っ た 。

表 1

ξλ	注入イオン	DITE	PASHAG	∄λ ∦ (lons∕
16		(kcY)	(;)	cm ²)
1	N *	130	1475	10.6×101
2	N 2 *	140	175	2.2×1016
3	N 2 *	8.0	450	1.2×1016

である。こうして分が曲線が決まれば、こうした曲線を鉄薄膜中に形成するのに必要な空流イオンの超弧、加速電圧、それによる空流イオンの平均投射飛程(平均侵入疎さ)、注入量が決定される。空流イオンの選択法は上述したが、平均投射飛程は加速電圧に依存する。

M g O 単結品 基板上のエピクキシャル 成長させた 鉄 ヴ 膜 は (100) に 配向した 単結晶の ヴ 膜であり、これに 注入された 窒素イオンは 第 2 図にみる如く C 軸に 選択的に入り、 C 軸を若干 仲 ばした 形の b.c.t. 構造か、 規定の N 位置に きちんと入っていない 前段階組織(マルテンサイト組織とも呼ぶ)となる。

前述の他の種々の製造方法では登業量の正確な制御ができないため、FesN2より安定なFesN、FesNやFezNといった、目的とするFesN2より高次の空化物ができてしまう。

しかし本発明の製造方法は注入する窒素イオンの注入エネルギーの他に、その種類を選択す

注入後の試料を高感度試料振動型磁束計で測定した結果を第3図に示す。

比較例としてイオン注入前の試料の飽和磁化の値 (σ)を示した。両者のσ値の比は 注入後σ/注入前σ=1.15であった。

MgOの単結晶基板上に鉄の単結晶膜を2000 Aの厚さで形成し、これに窒紫イオンを加速電 近140keV、注入量 4×10¹*ions/cs ² (N2 *) の条件で注入した。この膜の窒紫イオンの注入 状態をオージェ・デブス・プロファイリングで 深さ方向に調べた結果を第4図に示す。

第4図では機軸はArガスによるスパッタ時間で示しているが、これは試料の厚さ方向の距離と比例している。

試科最表面は酸素の付着が認められる。深さ方向のほぼ中心付近で窒素減度が凡そ10%程度であることが判り、この付近での鉄減度との比較からFesN2に相当することが判る。

この試料を注入直後と、 5×10^{-7} Torrの真空

中で 150℃、2時間の熱処理を行なった後のX 韓回折凶を歩う凶に示す。第5凶aは窒素イオー ンの注入前で、第5凶りは注人後を示す。エピ タキシャルに成膜された F e の (200) 面回折線 は窒素イオンの注入によりFegNzの強い (004) 面反射と弱い 残留 F e の(200) 反射に分 難した。さらに回折弦皮を上げると第5四Cに 示すように 2θ-28° 付近にFeゅN2の(002) 反射が認められ、FesN2の形成を裏付けた。 (004) 面の反射は窒紫イオン注入後には明瞭な 回折線は認められず、然処理後にはっきりす る。このことは窒素イオン注入のままでは FenN2指子をきっちりと形成していない領 技も熱処理により Fe s N 2 格子を形成する領 はへと変わることを意味する。第4図のオージ ェ分析にみるようにイオン注入後の窒素の分布 はゆるやかな勾配を示し、その局部的な領域で 調べるなら、FeaN2格子をきっちりと形成 していない領域が存在することも理解できる。 [発明の効果]

以上述べた如く、本発明方法による FenNi化合物は極めて高い飽和磁化を有し、 磁気ヘッド材料、磁気遮蔽材料等飲質磁性材料 としての広い用途が見込まれる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の窒化鉄の薄膜中の窒素混 度の一例を示すグラフ、

第2図は、窒素が入った鉄の結晶構造を示す 模式図、

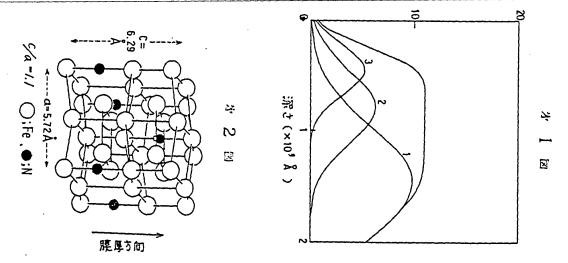
第3図は、磁場の強さと飽和磁化の値の関係 を示すグラフ、

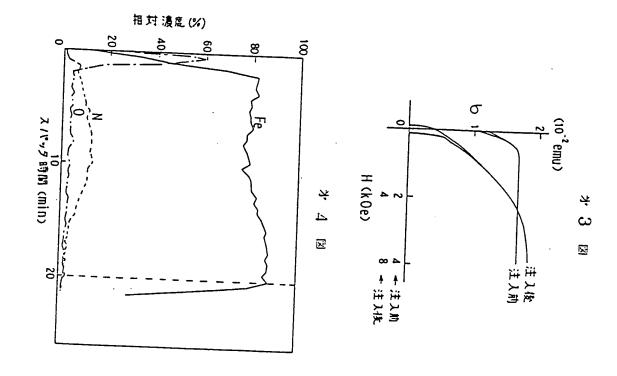
第4 図は実施例2の窒化鉄薄膜の深さ方向の成分の濃度分布を示すグラフ、

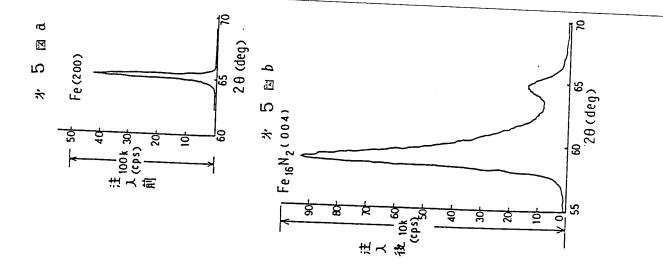
第5図a~cは上記海膜のX線回折図である。

特許出版人 三菱型鋼体式会社 代理人 弁理士 小 松 务 岳 代理人 弁理士 旭 宏 代理人 弁理士 加々美 紀進

窒素イオン濃度 N/Fe+N(0t%)







オ 5 図 C

